



مجله سنجش و ايمني يرتو، جلد ٦، شماره ٤، تابستان ١٣٩٧

# بررسی خواص سوسوزنی بلورهای (CsI(Tl رشد داده شده با آلایندههای Ca و Tm

سجاد شاەملکی و فائزہ رحمانی\*

گروه فیزیک هستهای، دانشکده فیزیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران. \*تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک هستهای، کدپستی:۱۹۶۱-۱۹٤۱۸ پستالکترونیکی: FRahmani@kntu.ac.ir

### چکیدہ

در این پژوهش به ساخت بلورهای (SI(TI) طی رشد به روش بریجمن با استفاده از آلاینده هایی نظیر 20 و Tm بمنظور بررسی خواص سوسوزنی برای کاربرد به عنوان آشکاساز گاما پرداخته شده است. برای ارزیابی بلورهای رشد داده شده، پراش ایکس، طیف لیان نوری، طیف گرمالیانی و نیز طیفهای گامای ثبت شده توسط بلورها، بررسی شدند. همچنین پارامترهای سوسوزنی از جمله قدرت تفکیک انـرژی، پاسخ گرمالیانی و نیز طیفهای گامای ثبت شده توسط بلورها، بررسی شدند. همچنین پارامترهای سوسوزنی از جمله قدرت تفکیک انـرژی، پاسخ سوسوزنی بهره نوری و پس تاب مورد مطالعه و اندازه گیری قرار گرفتند. خواص سوسوزنی بلور (TI)SI) با آلاینده های مختلف نسبت به (TSI) به عنوان نمونه استاندارد (ساخت شرکت Amerys) مقایسه شدند. برای بلور ISO با آلاینده IT، بهره نوری ۸۷۰ ، قدرت تفکیک انرژی در (TI) به عنوان نمونه استاندارد (ساخت شرکت Amerys) مقایسه شدند. برای بلور ISO با آلاینده IT، بهره نوری ۸۷۰ ، قدرت تفکیک انرژی در (TI) به عنوان نمونه استاندارد (ساخت شرکت Amerys) مقایسه شدند. برای بلور ISO با کر ای الاینده IT، بهره نوری ۸۷۰ ، قدرت تفکیک انرژی (TI) باعث (TSI) به عنوان نمونه استاندارد (ساخت شرکت Amerys) مقایسه شدند. برای بلور ISO با که و TT بهره نوری ۸۷۰ ، قدرت تفکیک انرژی انرژی ازرژی با که موسوزنی می مورد (IT) به موسوزنی می شوند. افزودن آلاینده مای Ca و TT به ساختار بلوری (IT) باعث (IT) به مای تغییر خواص سوسوزنی می شوند. افزودن آلاینده مای TT در می تعان بلوری (IT) باعث (IT) به ماوری به ۲۰۰٪، قدرت تفکیک انرژی ۸۰٪ و پاسخ سوسوزنی می شوند. افزودن آلاینده موری می شونده (IT) بای که تری نینده باسخ سوسوزنی ما تعاد و ساخت انوری شده، از این رو باعث تغییر خواص سوسوزنی می شود. افزودن آلاینده موری به ۲۰۰٪، قدرت تفکیک انرژی ۸۰٪ و پاسخ سوسوزنی می موردند. افزودن آلاینده موردی باینده مورده را و پایسخ سوسوزنی مورده آلاینده دور را که می شود. آلاینده دوری را کنده و موری که و باین باین موری باین موری به در و را که می و رو را که می شود. آلاینده باین موسوزنی می موسوزنی مورد و بایند و بایند و باین بای موسوزی گره بایند و مویه را که می موده (IT) می موری و قده را که می و را که می مود. و IT) می موری و قدو و IT) می مورد و IT) موری و باین از می مولی و تا مولو موردی و IT) موری موری و بای از موری بای مولی و تا مور

**كليدواژگان**: يديد سزيم آلاييده، قدرت تفكيك انرژى، بهره نورى، زمان فروافت سوسوزنى، ليان نورى، گرماليانى.

#### ۱. مقدمه

روشهای موجود برای آشکارسازی و طیفنگاری بسیاری از پرتوها به شمار میآید. امروزه جستجو برای مواد سوسوزن جدید با توجه به نیاز روز افزون برای کاربردهای مختلف نظیر آشکارسازی پرتوهای یونیزان توسط نور سوسوزنی ایجاد شده در مواد سوسوزن، یکی از قدیمیترین روشهای ثبت پرتوها محسوب میشود. فرایند سوسوزنی یکی از مفیدترین

بازرسی صنعتی، دزیمتری، پزشکی هستهای، تشخیص پزشکی، فيزيک انرژي بالا، اکتشافات فضايي، چاه پيمايي و ... در حال انجام است. با توجه به اینکه هیچ ماده سوسوزن ایده آلی یافت نمی شود، لذا ویژگی های نامطلوب هر سوسوزن بر اساس نوع کاربرد می تواند باعث تغییر در دقت اندازه گیری شود، بنابراین انتخاب نوع آشکارساز به کاربرد آن بستگی خواهد داشت. آشکارساز ایکس و گاما بایستی دارای خروجی نور بالا، شفافیت نور بالا، قدرت جذب بالای فوتون، پستاب نوری کم (گسیل نور سوسوزنی تأخیری پس از نور سوسوزنی اصلی) و پاسخ سريع باشد [۱–٤]. يديد سزيم بهعنوان يک سوسوزن هالید قلیایی کاربردهای مختلفی دارد. دمای ذوب آن C° ۲۵۰ است و روش رشد بریجمن و چکرالسکی برای آن گزارش شده است. (CsI(Tl نور سوسوزنی با طول موج ۵۱۰ nm گسیل می کند که در نتیجه بازترکیب الکترون-حفره در حضور زیر تراز تالیوم می باشد [٥]. از جمله مزایای آشکارساز CsI(Tl) می توان به بهره نوری بالا، قدرت تفکیک انرژی مطلوب، چگالی بالا، نداشتن یس زمینه پرتوی داخلی، رطوبت پذیری پایین، فرآیند رشد و ساخت مناسب با توجه به دمای ذوب پایین و هزینه کم و نیز نرم بودن و شکل پـذیری مطلوب أن اشاره كرد. همچنين از معايب اين أشكارساز مي-توان به پاسخ زمانی کند حدود HS و پستاب طولانی اشاره کرد که در بازه ns، حدود ٪ه-٥/۰ کل نور خروجی را گسیل می کند. این مشخصه ها در مقایسه با (NaI(Tl، برای استفاده در طیفنگاری یک کاستی محسوب میشوند [7]. امروزه تحقیقات وسیعی در زمینه کاهش پــستـاب و افــزایش سرعت پاسخ گویی سوسوزنها صورت گرفته است. سوسوزن (CsI(Tl) همراه با دیگر آلاینده ها به منظور کاهش زمان پستاب، پاسخ زمانی سریع و بهینهسازی خواص آشکارسازی

<sup>1</sup> Bridgman

استفاده می شود. با توجه به تحقیقات انجام شده، استفاده از آلایندههای Eu, Sm, Yb, Bi و In به دلیل ایجاد تراز در ساختار شبکه یدید سزیم برای انتقال الکترون می توانند سرعت پاسخ سوسوزن را بهبود ببخشند و همچنین می توانند برای افزایش بهره نوری و قدرت تفکیک انرژی مطلوب مورد استفاده قرار گیرند [۷–۱۳]. در این پژوهش، بلورهای آشکارساز (CaF) با آلایندههایی نظیر 2GF2 (قلیایی) و روود آلایندهها به داخل شبکه بلور، تغییرات خواص ورود آلایندهها به داخل شبکه بلور، تغییرات خواص اثر آلایندههای Tm و Ca تاکنون بررسی نشدهاند، تأثیر افزودن این آلایندهها در ساختار بلوری (CaF) باعث تغییر چگالی این آلایندهها در ساختار بلوری (CaF) باعث تغییر چگالی مراکز به دام افتاده و زیر ترازهای لیانی می شوند، که در این تحقیق اندازه گیری و بررسی خواهند شد.

### ۲. روش کار

## ۱.۲. رشد بلور یدید سزیم با آلاینده های مختلف

تک بلورهای CsI با آلایندههای TI، Tm و Ca با استفاده از روش بریجمن در یک کوره شامل دو بخش فوقانی و تحتانی که با یک جرم نسوز<sup>7</sup> از هم جدا شدهاند، رشد داده شدند. شکل ۱ طرحی از سیستم ساخته شده رشد بلور به روش بریجمن و متعلقات آن را نشان میدهد. پودر CsI در تمام نمونهها به میزان یکسان و به همراه آلایندههای TT، TT و Ca مطابق با جدول ۱ در داخل بوته قرار داده شد.

در نمونهها.	آلاينده	مولى	درصد	:(١)	جدول
-------------	---------	------	------	------	------

درصد مولی آلایندههای //	درصد مولی آلاینده Tl	نوع آلايندهما	
ديكر	• /\**	TI	
•/Y	• /٣	Tl-Tm	
•/٢	• /٣	Tl-Ca	

<sup>3</sup> Baffle

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Czochralski



شکل (۱): طرحواره کوره دو بخشی مورد استفاده در رشد بلور به روش بریجمن، ۱: بلور، ۲: مذاب، ۳: راکتور، ٤: ورودی خلاء، ۵: قرائتگر خلاء، ٦: دستگاه کشنده /۱mm/۱ ۷: شیلد حرارتی، ۸: کوره منطقه ذوب، ۹: بوته، ۱۰: کوره منطقه سرد.

مواد اوليه (تهيه شده از كمپاني مرك' و آلدريچ' با درجه خلوص ۹۹/۹) پس از توزین در داخل بوته گلاسه (ظرف استوانهای با نوک مخروطی) ریخته شدند. بلور CsI باید در شرایط خلاء (بیش از mbar <sup>۱۰-۱</sup>) رشد داده شود [۱۵–۱۵]، بنابراین داخل کیسولی (آمیول) از جنس کوارتز قرار داده شـد. بوته به مدت ۲ ساعت در داغترین ناحیه کوره قرار گرفت تا تمام ماده ذوب شود. پس از آن بوته به سمت مناطق با دمای پایین تر سوق داده شد. به منظور دستیابی به توزیع یکنواخت آلاینده ها، عملیات حرارتی پس از رشد کامل بلور، طی ۲٤ ساعت در دمای C<sup>o</sup> ۰۰۰ به کوره اعمال شد. پس از آن کوره با نرخ °C • ۰ بر ساعت سرد شد. به منظور اطمینان از يكنواختي توزيع آلايندهها در سرتاسر بلور، طيف فوتولومینسانس و طیف گاما بر اساس طول بلور گرفته شد که نتيجه يكسان به دست آمده نشان از يكنواختى توزيع آلاينده میدهد. شکل ۲ نمایی از بلور رشد داده شده را نشان میدهد. بلورهای شفاف و بدون ترک ، در ابعاد ۳ mm × ۰ × ۰ برش خورده و یولیش داده شدند. در بررسی نمونههای ساخته

<sup>1</sup> Merck

شده ضریب شکست بلور از پارامترهای مهمی است که باید در بلورهای سوسوزنی مورد بررسی قرار گیرد. نکته ای که لازم است به آن اشاره شود این است که CsI دارای ضریب شکستی برابر ۱/۷۹ است. در این پژوهش آلایندهها با مقادیر بسیار کم به محیط میزبان CsI اضافه شدهاند که اضافه کردن آلاینده در حد ٪ ۳/۰ مولی، تأثیر قابل مشاهده و قابل ملاحظه-ای روی ضریب شکست ندارد. سپس از نمونهها پراش ایکس، لیان نوری، طیف گاما و گرمالیانی گرفته شد.



شکل (۲): نمایی از بلور رشد داده شده (ابعاد بلور مخروطی به ارتفاع و قاعده ۲ سانتیمتری).

# ۲.۲. اندازه گیری پراش ایکس، لیان نوری، طیفنگاری گاما و گرمالیانی

اندازه گیری پراش ایکس از نمونه ها به جهت اطمینان از تک بلور بودن انجام شده است. طیف لیان نوری با استفاده از دستگاه LS55-Perkin Elmer در محدوده طول موج ۸۰۰ nm

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aldrich

خواص سوسوزنی نمونه ها با چشمه <sup>137</sup> و بدون سطح بازتابنده انجام شد. سپس بهره نوری، قدرت تفکیک انرژی و پاسخ زمانی نمونه ها در مقایسه با نمونه استاندارد [17] اندازه-گیری شد. شکل ۳ پیکربندی یک سیستم آشکارسازی برای آشکارساز سوسوزن را نشان میدهد. برای اندازه گیری گرمالیانی(با نرخ گرمادهی Sec/ <sup>20</sup> ۱۰ با قرائت گر مدل (Harshaw)، نمونه ها به مدت ۲ ساعت تحت تابش چشمه <sup>90</sup>Sr بتازا قرار گرفتند. برای اندازه گیری گرمالیانی سعی شد که تمام نمونه ها با وزن یکسان و ابعاد ۳ mm × ه × ه برش



## ۳. بحث و بررسی

شکل ٤ ساختار بلوری CsI رشد شده را نشان میدهد. اندازه گیری پراش ایکس از نمونه ها به جهت اطمینان از تک بلور بودن انجام شده است. مشخصه یابی نمونه CSI نشان دهنده ساختار مکعبی و تک بلور بودن نمونه است. همچنین با توجه به اینکه مقدار آلاینده ها، در نتایج پراش ایکس تغییرات محسوسی ایجاد نمیکند، پراش ایکس برای نمونه های با آلاینده انجام نشد. شکل ٥ طیف گسیل نمونه های رشد داده شده را که با طول موج mn ۸۰۸ (بیش ترین طول موج تحریک نوع آلاینده ها، شدت طیف گسیل تغییر میکند. شدت طیف نوع آلاینده ها، شدت طیف گسیل تغییر میکند. شدت طیف پیش تر می باشد که این اثر مربوط به ورود یون Tm می باشد. به دلیل ایجاد زیر تراز TT، شدت قله گسیل مربوط به زیر تراز دلیل ایجاد زیر تراز TT، شدت قله گسیل مربوط به زیر تراز

TT تقویت شده است. همانطور که در شکل ۵ مشاهده می شود، افزودن آلاینده اباعث تغییر شدت و یا همان سطح زیر قله طیف گسیل می شوند، اما قله نوری مربوط به TT در همان طول موج nn ۰۱۰ مشاهده می شود که مطابق با نتایج ارائه شده در دیگر مقالات می باشد [۱۷]. رفتار طیف گسیل نمونه ها شده در دیگر مقالات می باشد [۱۷]. رفتار طیف گسیل نمونه ها آن ها با هم متفاوت می باشد. این امر نشان دهنده این است که کاتیون های F تأثیری در نتایج طیف لیان نوری و همچنین ایجاد قله گسیل دیگری ندارند. بر اساس این استدلال می توان با یک نوع لامپ تکثیر کننده فوتون (PMT)، مشخصه سوسوزنی نمونه ها را بدون توجه به بازده کوانتومی اندازه گیری کرد. لازم به ذکر است با این روند نتایج حاصل از مشخصهیابی سوسوزنی صرفاً به مشخصه اصلی سوسوزن ها بستگی دارد و نوع TM در نتایج سوسوزنی اثرگذار نیست. همچنین در این نوع TM مدل 2020X استفاده شده است [۸۲].



بودن نمونه CsI.



شکل (٥): طیف گسیل نمونهها با طول موج تحریکی m٠٨ nm.

شکل ۲ شدت قله گسیل نمونهها را در بازه های زمانی M . انشان می دهد. ثابت  $\lambda$  (ثابت زمانی فروافت سوسوزنی) با استفاده از شکل ۲ حاصل از طیف لیان نوری، محاسبه شد. برازش نمایی به طیف خروجی مربوط به ثابت زمانی فروافت سوسوزنی نمونهها انجام شد. رفتار زمانی شدت قله گسیل بر اساس مجموع زمان نور سوسوزنی به صورت کند و سریع می باشد (شکل ۷). همین فرایند بر روی دیگر نمونهها نیز انجام شد. لازم به ذکر است که همین فرایند برای نمونه استاندارد نیز انجام شد که با نتایج آن با نتایج گزارش شده توسط دیگران مطابقت دارد ( نتایج در جدول ۲) [۱۳].



شکل (٦): طیف زمان فروافت سیگنال سوسوزنی بر اساس شدت گسیل

نمونەھا.



نمونه (CsI(TI-Tm با پاسخ زمانی در حدود ۵/۸۲۰۳.

در شکل ۸ نمونه طیف خروجی آند PMT برحسب زمان-ولتاژ برای نمونه استاندارد (IT) csl نشان داده شده است. برای محاسبه زمان فروافت سوسوزنی از شکل پالس ولتاژ حاصل از آند لامپ تکثیرکننده فوتونی استفاده شد. به منظور میانگین گیری، آزمایش برای بیش از ۱۰ پالس تکرار شد. زمان فرو افت سامانه الکترونیکی برای همه نمونهها ثابت است. رفتار زمانی لبه بالارونده پالس توسط زمان فروافت مدار آند،  $\frac{1}{\theta} = 2R$  و رفتار زمانی دنباله پالس بر اساس زمان فروافت سیگنال سوسوزنی میباشد [٥]. برای محاسبه  $\Lambda$  از برازش نمایی به طیف خروجی مربوط به نمونهها استفاده شد. بهمنظور بررسی صحت آنالیز انجام شده، همین فرایند بر روی است.این نتایج از پاسخ زمانی حاصل از طیف گسیل نمونهها کسر شدند تا مؤلفههای پاسخ زمانی سوسوزنی کند و سریع مشخص شوند.



شکل (۸): طیف خروجی آند برای نمونه استاندارد (CsI(Tl با ارزیابی پاسخ زمانی ۹۷۶ ns.

شکل ۹ طیف گامای هر یک از نمونهها را در مقابل چشمه <sup>137</sup>Cs با انرژی ۲۹۲ keV نشان میدهد. قدرت تفکیک انرژی و بهره نوری نمونهها با نمونه استاندارد مقایسه شدند (جدول ۲).



شکل(۹): طیف ارتفاع پالس نمونهها در انرژی ۲۹۲ keV در بازه زمانی ۱۵۰ s.

پستاب، ناشی از بازترکیب تابشی الکترون ها و حفره ها است که با تأخیر زمانی رخ میدهد. با توجه به نوار انرژی بلور (CsI(Tl، قسمتي از الكترونها در مراكز دام الكتروني <sup>+</sup>Tl گير افتاده و پس از مدتی با اثر گرمایی از دام رها میشوند که فقط با مراکز دام حفرهای یا حفره های به دام افتاده (مراکز <sup>+</sup>Tl) بازترکیب دارند، بنابراین گسیل متناظر با آن (پس تاب) با تأخیر قابل ملاحظهای اتفاق میافتد. با افزایش دما در فرایند گرمالیانی، این الکترونهای به دام افتاده در مراکز دام الکترونی آزاد شده و به نوار هدایت منتقل می شوند، لذا گرمای مـنظم و افزایش تدریجی دما باعث رهایی حاملهای بار از دام و گسیل تابشی از مراکز لیانی میشود. سطح زیر منحنی گرمالیانی، چگالی الکترونهای به دام افتاده را نشان مـیدهـد کـه در اثـر گرما از دام رها شده و با مراکز دام حفرهای بازترکیب شده و به گسیل تابشی تبدیل شدهاند. لذا سطح زیر منحنی گرمالیانی بیانگر میزان دام الکترونی در ساختار شبکهای میباشد، که اگر این مقدار کم باشد، نشاندهنده کم بودن چگالی مراکز دام الکترونیی در ساختار شبکهای است. همچنین مکان قله گرمالیانی در دماهای کم ظاهر می شود که نشان میدهـد عمـق چگالی دام الکترونی در ساختار شبکهای کم است، لـذا فراینـد رهاسازی در مدت زمان کمتری انجام می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که پستاب یا تأخیر زمانی سوسوزن، دارای

شدت کمتری است. برای اندازه گیری پستاب از مکانیزم مبتنی بر فرایند گرمالیانی استفاده شد. لازم به ذکر است که پس زمینه دستگاه قرائت گرقبل از پرتودهی nQ ۵ اندازه گیری شده است. این اندازه گیری ها فقط برای نمونه های رشد داده با مقدار آلاینده TI یکسان انجام شد. لذا با توجه به عدم اطلاع از مقدار آلاینده TI در نمونه استاندارد، مقایسه و گزارش نتیجه برای نمونه استاندارد ارائه نمی شود. شکل ۱۰ و جدول ۲ نتایج حاصل از منحنی گرمالیانی را نشان می دهد. با توجه به شکل ۱۰ می توان اثر پس تاب را در نمونه ها نسبت به نمونه (CsI(TI) به صورت زیر توضیح داد:

بر اساس نتایج، سطح زیر منحنی طیف گرمالیانی در نمونه (CsI(TI-Ca) افزایش یافته است که نشان می دهد چگالی مراکز دام الکترونی در ساختارشبکهای نسبت به نمونه (TI) CsI بیش تر می شود. همچنین در این بلور، قله گرمالیانی نمونه در دمای بالاتر نمایان شده است که نشان می دهد عمق چگالی دام الکترونی در ساختار شبکهای بیش تر شده است، بنابراین باعث می شود در مدت زمان طولانی تری فرایند رهاسازی رخ دهد. پس انتظار می رود که این نمونه پس تاب بیش تـری نسبت به نمونه (TI) داشته باشد. این نتایج با اندازه گیری زمان فروافت سوسوزنی کند که در جدول ۲ (ستون ج و د) نشان داده شده است، همخوانی دارد.



شكل (۱۰): طيف گرمالياني نمونهها.

#### جلد ششم، شماره ۴

همچنین سطح زیر منحنی طیف گرمالیانی نمونه (CsI(TI-Tm کاهش پیدا کرده که نشاندهنده کاهش چگالی مراکز دام الکترونی در ساختارشبکهای نسبت به نمونه (CsI(Tl است. قله گرمالیانی نمونه در دمای پایینتر نمایان شده است که نشاندهنده عمق کم چگالی دام الکترونی در ساختار شبکهای و به دنبال آن مدت زمان کوتاهتر فرایند رهاسازی است.

پس انتظار می رود که این نمونه نسبت به نمونه (CsI(Tl) پس تاب کم تری داشته باشد (جدول ۲).



شکل (۱۱): مقایسه خواص سوسوزنی نمونهها (مطابق جدول ۲) با آلایندههای متفاوت با نمونه استاندارد.

جدول(۲): خواص سوسوزنی نمونهها، (الف): زمان فروافت سوسوزنی قله گسیل حاصل از طیف لیان نوری، (ب): زمان فروافت سوسوزنی حاصل از طیف پالس آند نمونهها در مقابل چشمه <sup>137</sup>Cs، (ج): اختلاف الف و ب به عنوان زمان فروافت کند سوسوزنی یا همان پس تاب نمونهها، (د): سطح زیر منحنی گرمالیانی به عنوان شاخص پس تاب، (ه): ارتفاع تمام قله گاما نمونهها در مقابل چشمه <sup>137</sup>Cs، (و): بهره نوری نمونه نسبت به نمونه استاندارد در مقابل چشمه <sup>137</sup>Cs.

قدرت تفکیک انرژی در keV ۲٦۲	بهره نوری (./) (و)	ار تفاع قله گاما. شمارش (ه)	سطح زیر منحنی گرمالیانی(nQ) (د)	زمان فروافت کند (μs) (ج)	زمان فروافت سريع (ns) (ب)	زمان فروافت (μs) (الف)	نوع آلايندهها
11	77	7.0	١٥٨٣٦	٤/٨١٧٧	1.02	O/AVIV	Tl(0.3)
٩/٧	٧.	091	1012.	٤/٤٤٧٣	1505	٥/٨٢٠٣	Tl-Tm(0.3-0.2)
١٢	٦٧	٣.٥	191.1	7/1417	077	7/11/1	Tl-Ca(0.3-0.2)
٨/ ٥	74	٦٣٦	٢٤٨٣٠	٤/٦٨٦	٩٧٤	0/77.	Tl- Original

که نسبت به حالت نمونه استاندارد کندتر میباشد. دلیل آن میتواند عدم تعیین غلظت بهینه TI باشد که در مجموع میانگین زمان پاسخ سوسوزنی را کندتر میکند. بدیهی است که این پدیده تأثیر بسزایی در طیفنگاری گاما داشته و روند سوسوزنی و همچنین میزان قدرت تفکیک انرژی را تحت تأثیر خود قرار داده است.

مقدار Tl در نمونه (CsI(Tl-Tm برابر نسبت وزنی نمونـه مقدار SI(Tl) است، ولی آلاینده Tm نیز به آن افزوده شـده اسـت. شکل ۱۱ مقایسه نتایج حاصل از خواص سوسوزنی نمونه-ها با نمونه استاندارد می باشد. با توجه به شکل ۱۱ و جدول ۲، خواص سوسوزنی نمونه (CsI(Tl) در مقایسه با نمونه استاندارد مطلوب نیست. قدرت تفکیک انرژی ٪۱۱ و بهره نوری آن نسبت به نمونه استاندارد ٪۹۷ اندازهگیری شده است. با توجه به زیرتراز لیانی Tl، پاسخ زمانی آن nm ۱۰۵٤ اندازه-گیری شده است. این اختلاف ناشی از سرعت انتقال انرژی زیرتراز لیانی Tl و طول عمر حالت گسیل از مرکز لیانی است

طیف گسیل آن نسبت به دیگر نمونه ها شدت بیش تری دارد. با توجه به شکل ۱۱ و جدول ۲، قدرت تفکیک انرژی در قله ٦٦٢ keV سزیم ۱۳۷ برابر ٪۹/۷ و بهره نوری آن نسبت به نمونه استاندارد ٪۲۰۳ اندازه گیری شده است که نسبت به نمونه (CsI(Tl نتایج مطلوب تری دارد.

با توجه به زیرتراز لیانی آلاینده های Tm و TT و TT، پاسخ زمانی (TI-TT)۱۳۷۳ nm Csl (TI-Tm)اندازه گیری شده است که پاسخ زمانی آن نسبت به نمونه استاندارد کندتر شده است. جذب و گسیل در زیرتراز لیانی Tm با گسیل زیرتراز TT همپوشانی دارد، بنابراین گذار انتقال انرژی در ساختار شبکهای بلور ایجاد میشود که به سبب آن آمار جمع آوری فوتون و شدت بهره نوری بیشتر شده، همچنین قدرت تفکیک انرژی نسبت به نمونه (CsI(TI) بهبود می یابد (شکل ۱۲).

مراکز دام الکترونی <sup>+2</sup>Tm کم عمق میباشند و پستاب و زمان پاسخ سوسوزنی تأخیری آن نسبت به نمونه (CsI(Tl کمتر است. این نتایج را میتوان در سطح زیر منحنی طیف گرمالیانی نمونه ملاحظه کرد. با توجه به همپوشانی گسیلهای مراکز T1 وTT پاسخ سوسوزنی افزایش مییابد.



شکل (۱۲): طرحوارهای از نوار انرژی آشکارساز (CsI(TI-Tm.

در نمونه (CsI(TI-Ca مقدار TI برابر نسبت وزنی نمونه (CsI(TI) است، ولی آلاینده Cs نیز به آن افزوده شده است. شدت طیف گسیل آن نسبت به نمونه (CsI(TI) بیش تر است. با توجه به شکل ۱۱ و جدول ۲، قدرت تفکیک انرژی با توجه به شکل ۱۱ و جدول ۲، قدرت تفکیک انرژی نمونه استاندارد ۸/۸ اندازه گیری شده است با توجه به زیرتراز لیانی آلاینده های Ca و TI، پاسخ زمانی آن mn ۳۷ اندازه-گیری شده است که نسبت به حالت نمونه استاندارد سریعتر است. آلاینده <sup>+2</sup>Ca با ایجاد تراز جدید انرژی، نقش دام مؤثر الکترونی را برای تسریع انتقال الکترون به تراز لیانی TI دارد (شکل ۱۳).

همچنین به دلیل عمیق بودن مراکز دام الکترونی <sup>+Ca2</sup>، پستاب و زمان پاسخ سوسوزنی تأخیری آن نسبت به نمونه (CsI(TI) بیشتر است. این نتایج را میتوان با توجه به سطح زیر منحنی طیف گرمالیانی نیز ملاحظه کرد. با توجه به این توضیحات، آمار جمع آوری فوتون کمتر شده و روند سوسوزنی و همچنین قدرت تفکیک انرژی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. همچنین اندازه گیری یکنواختی توزیع آلاینده در نمونهها نیز بسیار اهمیت دارد.



شکل (۱۳): طرحوارهای از نوار انرژی آشکارساز (CsI(TI-Ca.

## ٤. نتيجه گيرى

در این پژوهش، بلورهای آشکارساز (CsI(Tl) با آلاینده-هایی نظیر Ca و Tm به روش بریجمن رشد داده شدند. با ورود این آلاینده به داخل شبکه بلور (CsI(Tl)، خواص سوسوزنی برای دستیابی به عملکرد مطلوب برای آشکارسازی گاما مورد بررسی قرار گرفت. آلاینده <sup>+2</sup>Tm در ساختار شبکه-ای (CsI(Tl) منجر به افزایش بهره نوری و بهبود خواص ای (TS)IC منجر به افزایش بهره نوری و بهبود خواص همپوشانی گسیل های مراکز TT و TT افزایش مییابد. با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری گرمالیانی، با ورود این آلاینده به داخل ساختار شبکهای (TS)، چگالی دام الکترونی کم عمق میشود که منجر به پستاب کمتری نسبت به نمونه (TS) اثر میشود که منجر به پستاب کمتری نسبت به نمونه (SI) اثر میشود که منجر به پستاب کمتری نسبت به نمونه (SI) اثر میشود دام الکترونی کم عمق نامطلوب در بهره نوری و قدرت تفکیک انرژی دارد، هر چند که ورود این آلاینده به دلیل ایجاد دام الکترونی و بازترکیب با

یون آلاینده <sup>+</sup>TI، باعث افرایش سرعت پاسخ سوسوزنی می-شود. بر اساس نتایج گرمالیانی، با ورود این آلاینده به داخل ساختار شبکهای (CsI(TI) چگالی دام الکترونی عمیقتر شده است و پستاب نمونه نسبت به نمونه (CsI(TI) بیشتر می-شود. مقدار ثابت زمان کند فروافت سوسوزنی با پستاب نمونهها رابطه مستقیم دارد که این تأثیر را میتوان در جدول ۲ و شکل ۱۰ مشاهده کرد.

بر اساس نتایج طیف لیان نوری و طیف گاما، اثر آلاینده (نوع و غلظت آلاینده) در شدت طیف گسیل و مشخصه سوسوزنی اثر بهسزایی دارد. برای دستیابی به بلوری با مشخصات سوسوزنی بهینه مورد نظر بر اساس پستاب و نیز بهره نوری، باید غلظت آلاینده ورودی بهینه شده و نیز بعد از رشد اندازه گیری شود که در ادامه این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

## ٥. مراجع

- [1] T. Jing, C. Goodman, J. Drewery, G. Cho, W. Hong, H. Lee, S. Kaplan, A. Mireshghi, V. Perez-Mendez and D. Wildermuth. Amorphous silicon pixel layers with cesium iodide converters for medical radiography, IEEE Trans. Nucl. Sci. 41 (1994) 903–909.
- [2] N. Martin. Scintillation detectors for x-rays, Meas. Sci. Technol. 17 (2006) 37–54.
- [3] A. Jhingan, P.Sugathan, GurpreetKaur, K. Kapoor, N.Saneesh, T. Banerjee, H. Singh, A. Kumar, B. Behera and B. Nayak. Front-end electronics for CsI based charged particle array for the study of reaction dynamics, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 786 (2015) 51–58.
- [4] W. Carel and V. Eijk. Inorganic scintillators in medical imaging detector, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 509 (2003) 17-25.
- [5] G.F. Knoll. Radiation Detection and Measurement, Third Edition, Wiley Inc., New York, (2000).
- [6] www.crystals.saint-gobain. com/sites/imdf.crystals.com /files/documents/Scintillation Arrays. sgc-arrayassemblies.pdf.
- [7] C. Brecher, A. Lempicki, S.R. Miller, J. Glodo, E.E. Ovechkina, V. Gaysinskiy, V.V. Nagarkar and R.H.

Bartram. Suppression of afterglow in CsI:Tl by codoping with Eu2+—I: Experimental, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 558 (2006) 450–457.

- [8] E. Ovechkinaa, V. Gaysinskiya, S. Millera, C. Brecher, A. Lempickib and V. Nagarkara. Multiple doping of CsI:Tl crystals and its effect on afterglow, Radiation Measurements 42 (2007) 541–544.
- [9] J. Glodo, Y. Wang, R. Shawgo, C. Brecher, H. Hawrami, J. Tower and S. Shah. New Developments in Scintillators for Security Applications. Physics Procedia 90 (2017) 285–290.
- [10] L.A. Kappers, R.H. Bartram, D.S. Hamilton, A. Lempicki, C. Brecher, V.Gaysinskiy, E.E. Ovechkina, S. Thacker and V.V. Nagarkar. A tunneling model for afterglow suppression in CsI:Tl, Sm scintillation materials, Radiation Measurements 45 (2010) 426– 428.
- [11] D. Totsuka, T. Yanagida, Y. Fujimoto, Y. Yokota, F. Moretti, A. Vedda and A. Yoshikawa. Afterglow Suppression by Codoping with Bi in CsI:Tl Crystal Scintillator, Applied Physics Express 5 (2012) 052601– 052603.

- [12] Y. Wu, G. Ren, M. Nikl, X. Chen, D. Ding, S. Pana and F. Yang. CsI:Tl+,Yb2+: ultra-high light yield scintillator with reduced afterglow, 3312, Cryst Eng. Comm 16 (2014) 3312–3317.
- [13] Y. Wu, G. Ren, F. Meng, .X. Chen, D. Ding, H. Li, S. Pan and L. Melcher. Scintillation Characteristics of Indium Doped Cesium Iodide Single Crystal, IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE 62 (2015) 571–576.
- [14] S. Singh, D. Desai, A. Singh, M.Tyagi, A. Sinha, S. Gadkari and S. Gupta. Growth of CsI:Tl crystals in carbon coated silica crucibles by the gradient freeze technique. Journal of Crystal Growth 351 (2012) 88–92.
- [15] A. Yoshikawa, Y. Yokota, Y. Shoji, R. Kral, K. Kamada, S. Kurosawa, Y. Ohashi, M. Arakawa, I. Chani, V. Kochurikhin, A. Yamaji, M. Andrey and M. Nikl. Development and melt growth of novel scintillating halide crystals. Optical Materials 74 (2017) 109–119.
- [16] http://www.amcrys.com/pdf/4281.pdf.
- [17] Y. Wu, G. Ren, M. Nikl, X. Chen, D. Ding, S. Pan and F. Yang. Ultralow-concentration Sm codoping in CsI:Tl scintillator: A case of little things can make a big difference, Optical Materials 38 (2014) 297–300.
- [18] http://www.photonis.com.